表面酸化カルボニル鉄粉メタルコンポジット磁心トランスの試作と フライバックコンバータへの応用

Fabrication of metal composite magnetic core transformer with surface-oxidized carbonyl-iron powder and its application to the flyback-type dc-dc converter

佐藤紘介^{a),b)†}・杉村佳奈子^{b)}・佐藤敏郎^{b)}・曽根原誠^{b)}・竹内英樹^{a)} ^{a)}長野県工業技術総合センター,長野県岡谷市長地片間町1-3-1(〒394-0084) ^{b)}信州大学工学部,長野県長野市若里4-17-1(〒380-8553)

K. Sato ^{a), b) †}, K. Sugimura ^{b)}, T. Sato ^{b)}, M. Sonehara ^{b)}, and H. Takeuchi ^{a)}

^{a)} Nagano Prefecture General Industrial Technology Center, 1-3-1 Osachi-katamacho, Okaya, Nagano 394–0084, Japan

^{b)} Faculty of Engineering, Shinshu Univ., 4-18-1 Wakasato, Nagano, Nagano 380-8553, Japan

The fabrication and evaluation of a flyback-type dc-dc converter with a metal composite magnetic core transformer consisting of surface-oxidized carbonyl-iron powder and epoxy resin is described. The windings of the transformer consisted of a copper-clad polyimide tape. Two windings with a different arrangement of primary and secondary windings were fabricated and disposed in the composite magnetic core. The flyback-type converter with fabricated transformer demonstrated a power conversion efficiency of 91%.

Key words: surface oxidized carbonyl-iron powder, metal composite magnetic core, transformer, coupling coefficient, flyback-type converter, power conversion efficiency

1. はじめに

近年,高周波スイッチング動作が可能で,低オン抵抗,高温動作が可能といった特長から,SiC/GaNパワーデバイスのパワーエレクトロニクスへの応用が進んでいる^{1),2)}.これらを用いると,スイッチング電源など電力変換回路の高効率化が可能であるとされる.またスイッチング周波数を数 MHz~数+ MHz へ高周波化できるとされ,電力変換回路小型化の妨げとなっている磁気デバイス等の小型化が可能になる.しかしながら,現状多用されているダストコアや Mn-Zn フェライトは,1 MHz を超える周波数での電力変換回路への適用は困難であると考えられる.

筆者らは MHz 帯スイッチング電源への適用を目指し, 鉄系メタルコンポジット材料 ³⁾を用いたパワーインダクタ, トランスの開発を進めている.例えば,大気中熱酸化によ り高抵抗被膜処理したカルボニル鉄粉メタルコンポジット 磁心インダクタを 1 MHz スイッチング非絶縁降圧型 DC-DCコンバータへ適用することで,効率は最大93~95% が得られたことを報告した^{4),5)}.また,メタルコンポジット 磁心と磁性めっきリッツ線を組み合わせたトランスを MHz スイッチング LLC 電流共振コンバータへ適用したと ころ,60 W 出力時に91%,120 W 出力時に89%の効率が 得られた⁶⁾.本研究は,絶縁型 DC-DC コンバータとして 比較的出力電力が小さな用途に用いられるフライバックコ ンバータのトランス磁心材料として,メタルコンポジット 材料の適用を目指したものである.

現在,ACアダプタ等に適用されている PWM 制御フラ イバックコンバータは,数十 kHz~数百 kHz 程度でスイッ チング動作させ,トランス磁心には Mn-Zn フェライトを用 いているものが多い. Mn-Zn フェライトは飽和磁化が 0.5 T程度であり、また MHz 帯における損失が大きい⁷⁾. さら に、直流重畳特性改善と励磁インダクタンス調整のためト ランス磁心にギャップを設けて用いるが、ギャップからの 漏れ磁束による電磁ノイズ、漏れ磁束が巻線や周辺部品を 通過することによって生じるうず電流損失の増大、および それに伴う温度上昇などの要因となる⁸⁾.

これまで開発してきた鉄系メタルコンポジット材料は、 1.6µm 径のカルボニル鉄粉を出発材料として、コンポジッ ト中での鉄粉同士の電気的接触を抑制する目的で大気中熱 酸化した高抵抗被膜鉄粉を用い、エポキシ樹脂と複合化し て作製される.非磁性樹脂と複合化しても1T程度の高い 飽和磁化を有するため、エネルギー密度を高めることがで き、トランス磁心の小型化が可能になる.また高抵抗被膜 付き微粒子を用いるため、高周波帯での渦電流損失を抑制 できる.加えて、微粒子間の非磁性樹脂が磁気ギャップと して作用するため磁気飽和しにくく、優れた直流重畳特性 を示し^{4).5)}、トランス磁心をギャップレスにできると考えら れる.一方で比透磁率が低いため励磁インダクタンスが小 さく、巻線間の結合係数を高めにくいため⁵⁾、動作時のサ ージやリンギングが大きくなりやすいといった課題がある.

本論文では,表面酸化カルボニル鉄粉メタルコンポジット磁心トランスの試作とフライバックコンバータへ応用した際の結果について報告する.

表面酸化カルボニル鉄粉メタルコンポジット 磁心材料の特性

2.1 表面酸化カルボニル鉄粉メタルコンポジット磁心材料

メタルコンポジット材料の磁性微粒子として, BASF 社 製の非還元カルボニル鉄粉を用いた.カルボニル鉄粉は平 均粒径 1.6 µm のほぼ球形であり, as-made 非還元状態で 20 nm 程度の微結晶組織と表面磁極を生じないボルテック ス磁気構造を有することがわかっている³⁾.

ここで、球形磁性粉末粒子において生じるうず電流損失 Waは次式で表される⁹.

$$W_{\rm e} = K \frac{\left(\pi dB_{\rm m} f\right)^2}{20\rho} \,. \tag{1}$$

式(1)において、Kはメタルコンポジット材料中の磁性粉末 充填率、dは磁性粉末粒子径[m]、 B_m は最大磁束密度[T]、 fは周波数[Hz]、 ρ は磁性粉末の抵抗率[$\Omega \cdot m$]である. カル ボニル鉄粉を最稠密充填したメタルコンポジット材料では、 鉄粉同士が接触することでうず電流が複数の鉄粉を電流経 路として流れてしまうことが想定される. このとき、式(1) の粒子径 dが大きくなるとみなせ、うず電流損失は増大す る. そこで、200°C・6 hの大気中熱処理を行うことで微粒 子表面に 25 nm~65 nm に高抵抗酸化被膜を形成し、鉄粉 間を絶縁した. 表面酸化カルボニル鉄粉と2 液性エポキシ 前駆体溶液を混合し、120°C・5 hの熱処理により硬化させ、 89wt.%表面酸化カルボニル鉄粉メタルコンポジット材料 を作製している.

既に報告したように⁵⁾,高抵抗酸化被膜付きカルボニル 鉄粉/エポキシコンポジット材料の体積抵抗率は酸化被膜 なしカルボニル鉄粉を用いた場合の 65 m Ω ・m から 100 Ω ・m と 1500 倍程度高くなり, Mn-Zn フェライトの体積 抵抗率に比べても 100 倍以上高い.これにより,うず電流 の鉄粉微粒子内への閉じ込めが期待され,コンポジット磁 心のうず電流損失を抑制できると考えられる.

2.2 表面酸化カルボニル鉄粉メタルコンポジット磁心材料 の電磁気特性

Fig. 1(a)に試料振動型磁力計(理研電子; BHV-55)によって測定した静磁化曲線を示す. Fig.1より, 飽和磁化 $M_s = 1.01$ [T], 保磁力 $H_c = 3.8$ [kA/m]である.

Fig. 1(b)にはインピーダンス/マテリアルアナライザ (Agilent technologies; 4291B) および磁性体テストフィク スチャ (16454A)を用いて測定した複素比透磁率の測定 結果を示す. 同図より,複素比透磁率の実数部は約 6,虚 数部は 10 MHz 以下において 10⁻²オーダーの小さな値と なる. なお, Fig. 1(b)は 1 MHz 以上の測定結果のみだが, 1 MHz 未満でも同等の特性を示すと考えられる.

Fig. 1(c)に複素比誘電率の測定結果を示す. 10 MHz 未満 では、LCR メータ (Agilent technologies; E4980A) および 誘電体テストフィクスチャ (16451B) を用い、電極非接触 法(間隙法) により測定した. 10 MHz 以上では、ネット ワークアナライザ (Agilent technologies; N5247A) を用 い、同軸伝送法により測定した. Fig. 1(c)より DC-DC コン バータのスイッチング周波数として想定している 100 kHz ~1 MHz において、複素比誘電率の実数部&'は 60~40 程 度、虚数部&''は 25~8 程度であった. エポキシ樹脂の比誘 電率&' = 2.7 よりも大きな値となったのは、メタルコンポ ジット材料内の鉄粉を経路として流れる変位電流成分が大



(c) Complex permittivity

Fig. 1 Electromagnetic properties of metal composite magnetic core material consisting of surface-oxidized carbonyl-iron powder and epoxy resin.

きいことや、低周波帯では虚数部&"が大きいことから伝導 電流成分も大きく、見かけ上の静電容量が大きくなったた めと考えられる.

3. 鉄系メタルコンポジット磁心トランス

3.1 トランス構造と作製方法

前章で示した通り、表面酸化カルボニル鉄粉メタルコン ポジット磁心は比透磁率が約6と低いため励磁インダクタ



Fig. 3 Winding structure of fabricated transformer.

ンスが小さく,漏れ磁束が多いことによって巻線間の結合 係数を高くすることが難しいという課題がある.よって, インダクタンス係数 AL を大きくできるトランス構造にし た上で必要な巻数を確保し,かつ磁気結合を強めて漏れ磁 束の少ない巻線構造を採用する必要がある.

そこで本研究では, Fig. 2 に示したように 40 mm 角, 10 mm 厚の磁心内部に巻線を配置する構造(外鉄型)とした. これにより同程度の寸法のトロイダルコアや EE 型コアな どと比較して実効磁路断面積を大きく,実効磁路長を短く できる.

巻線には 100 μm 厚, 5.2 mm 幅のポリイミドシート上に 70 μm 厚, 5 mm 幅の導体ラインが形成された,テープ状 の銅張ポリイミドシートを用いた.巻線間隔を小さくする ことで巻線間の磁気抵抗を大きくし,巻線間を通過してし まう漏れ磁束を減らして磁気結合を強めることができると 考えられる.1次巻線と2次巻線の配置は,Fig.3に示す ような 2 種類とし,以降では便宜的にそれぞれを type-A, type-B と称す.

type-Aは1次巻線、2次巻線がそれぞれ1本ずつで構成 される.2次巻線を巻き始める位置を調整し、巻線断面を 見たときに1次巻線の中央付近に配置されるようにしてい る.一方、type-Bは1次巻線2本、2次巻線1本で構成さ れ、2次巻線を2本の1次巻線の間にサンドイッチした状 態で巻くことで、断面構造を見ると1次巻線の間に2次巻 線が均等間隔に配置される構造となる.2本の1次巻線は 一方の巻き終わりともう一方の巻き始めを磁心外部で接続 している.type-A、type-Bのどちらの巻線構造においても、 巻線から磁心外部への引き出し線は、巻線と同じ銅張ポリ イミドシートを用いている.

トランスの作製方法は以下の通りである.内径 17.5 mm の空心巻線を作製し、さらにポリイミドテープで空心巻線 の導体露出部を被覆してメタルコンポジット材料と直接接 触しないようにする.空心巻線を鋳型中に配置し、前述の 表面酸化カルボニル鉄粉と2液性エポキシ前駆体溶液を混 合したスラリを充填した後、熱処理により硬化させる.そ の後、鋳型から取り出し、研磨によって寸法を調整してい る.前述の通り磁心はギャップレスである.

なお、一般的にトランスの巻数(励磁インダクタンス) および巻数比は、コンバータ入出力の仕様、使用する磁心 の特性(磁化曲線上の動作点)、パワーデバイスの定格など を考慮して決定するが ⁷⁾、本論文では基礎的検討のためそ のような設計手法は取らず、巻数比は 2:1 とした.また、1 次巻線の巻数はインダクタンスが 20 µH 程度となるように、 後述する電磁界シミュレーションの結果から 16 ターンと している.

3.2 電磁界シミュレーション

本論文で扱うトランスは、巻線に銅張ポリイミドシート を使用しているため隣接導体との間隔が狭い上に対向面積 が大きく、自己共振周波数低下の要因になる寄生容量が大 きくなる.そこで、Fig. 3 に示したトランス磁心およびス パイラル状巻線をモデリングして、CST MW-Studio を用 いた 3 次元電磁界シミュレーションにより、トランスの動 作解析を行った.解析条件を Table 1 に示す.メタルコン ポジット材料の複素比透磁率 (μr*=μr'-jμr") および複素 比誘電率 (Gr*=Gr'-jGr") は Fig. 1(b), (c)に示した値を用い、 ヒステリシスは考慮していない.交流導電率Gt複素比誘電 率の虚数部Gr"から次式で計算される.

$$\sigma = 2\pi f \varepsilon_0 \varepsilon_r'' \,. \tag{2}$$

解析は反射係数法による定常解析を行い,得られたSパ ラメータからシミュレータのポスト処理により等価直列イ ンダクタンス L_sおよび等価直列抵抗 R_sを導出している. 結合係数 k は,2 次側開放時および短絡時の解析を行い, それぞれの場合の1次巻線の等価直列インダクタンス L_{open} および L_{short} から次式により計算した.

$$k = \sqrt{1 - L_{\rm short} / L_{\rm open}} \ . \tag{3}$$

Part	Material	Constant
Magnetic core	Metal composite material	Complex permeability: shown in Fig. 1(b).
		Complex permittivity: shown in Fig. 1(c).
		AC conductivity: calculated by Equation (2).
		Thickness: 10 mm, External dimensions: 40×40 mm ²
Windings	Cu	Conductivity: 5.8×10 ⁷ S/m
		Thickness: 70 µm, Width: 5 mm
		Number of turns: primary 16turn, secondary 8 turn
Insulator layer	Polyimide	Complex permittivity: ε_r =3.5 (const.), ε_r =0 (const.)
		Conductivity: 0 S/m
		Thickness: 100 µm, Width: 5.2 mm

Table 1 Electromagnetic field analysis conditions for metal composite core transformer.

4. 試作トランスの特性

4.1 電気的特性

Fig. 4, Fig. 5 にインピーダンス/ゲインフェーズアナラ イザ (Agilent technologies;4194A) による測定値 (〇, ●) および電磁界シミュレーションによる計算値 (実線,破線) を示す. 結合係数は, 2 次巻線開放時および短絡時の 1 次 巻線の等価直列インダクタンスの測定結果から,式(3)を用 いて導出している. 同図より,全体の傾向は一致している ものの, DC-DC コンバータのスイッチング周波数として想 定している 100 kHz~1 MHz において,等価直列インダク タンス L_s の測定値は計算値より 20%程度小さい. これは後 述する磁心内における巻線位置ずれの影響が大きいものと 考えられる. 2 種類のトランスを比較すると, type-A の自 己共振周波数の方が高いこともあり,等価直列抵抗 R_s は低 くなる. なお,各巻線の直流抵抗 R_{DC} は,どちらのトラン スにおいても 1 次巻線は約 70 mΩ, 2 次巻線は約 37 mΩで ある.

結合係数は 100 kHz~1 MHz において, type-A は約 0.984, type-B は約 0.992 となった. どちらも計算値より 低いが, 等価直列インダクタンス L_sが計算値よりも小さく なったことや, シミュレーションモデルには磁心内巻線か ら外部への引き出し線が含まれていないため, そこでの漏 れインダクタンスの影響などが原因と考えられる. type-B の方が高い結合係数を示す理由は, 1 次巻線の間に 2 次巻 線が均等間隔に配置されることで 1 次起磁力と 2 次起磁力 の相殺が効果的に行われているためと推察される.

自己共振周波数は、type-A で 12.6 MHz, type-B で 2.7 MHz となった.寄生容量 $C_{\rm p}$ は、10 kHz における等価直列 インダクタンス $L_{\rm s}$ および自己共振周波数 $f_{\rm s}$ から次式により 試算した.

$$C_{\rm p} = 1 / \left\{ (2\pi f_{\rm r})^2 L_{\rm s} \right\}. \tag{4}$$

寄生容量 C_pは, type-A は約 10 pF, type-B は約 220 pF と,約 22 倍の差が現れている.電磁界シミュレーション結 果と式(4)から求めた値もそれぞれ 12.2 pF, 263 pF となり, 値は 20%程度異なるものの,測定値と同じく約 22 倍の差 が現れる.図示はしていないが,空心巻線でも同様に寄生



Fig. 4 Frequency dependence of inductance, resistance, and coupling coefficient of "type-A" transformer, where plots are measured results and solid and dashed lines are calculated ones.



Fig. 5 Frequency dependence of inductance, resistance, and coupling coefficient of "type-B" transformer, where plots are measured results and solid and dashed lines are calculated ones.

容量に大きな差が生じる.ゆえに,巻線構造の違い(巻線 配置の違い)による電界分布の変化に起因するものと考え られ,これについては後で考察する.

4.2 巻線位置ずれの影響

前節の結果から、本論文で扱うトランスは磁心内の巻線 位置ずれによる特性低下が示唆された. Fig. 2 に示した構 造から磁心幅方向の巻線位置ずれによる影響は小さいと考 えられる.しかし、厚さ方向の位置ずれは実効磁路断面積 の変化が大きく、トランスの特性に与える影響が大きくな ることが想定される.そこで、Fig. 6 に示すように磁心中 央部と巻線中央部の距離 dを変化させた際の電気的特性の 変化を電磁界シミュレーションにより検討した.d = 0 [mm]は巻線が磁心中央部に配置されているとき、d = 2.5 [mm]は磁心下端と巻線下端が一致している状態である.な



Fig. 6 Analysis model of the winding position shift.



Fig. 7 Effect of winding position shift.

お、トランス構造の対称性から、巻線が上方へずれたとき の電気的特性も同様な変化をすると考えられる.

Fig. 7より,等価直列インダクタンス L。は位置ずれ量 d< 1 [mm]ではそれほど変化しない.しかし, d>1 [mm]とな ると変化量が大きくなる.これは,巻線位置ずれにより巻 線下側の磁路断面積が小さくなることが原因と考えられる.

一方,等価直列抵抗 R。もわずかに低下する結果となった. これは,以前報告した 2次元磁界解析¹⁰⁾とは異なる結果で ある.巻線位置ずれにより,ずれた側の磁路断面積が狭く なると巻線導体中を通過する磁束が生じ,うず電流損失が 増大して R。は大きくなる.3次元電磁界シミュレーション でもこの様子は確認される.しかしながら,L。が低下する ことで自己共振周波数が高周波化し,見かけ上 R。が低下し たものと考えている.

結合係数kも位置ずれ量dが大きくなるのに伴い低下す るが、type-Bの方が低下幅は小さい.これは、前述の通り type-Bの巻線構造の方が、1次起磁力と2次起磁力の相殺 が効果的に行われているためと考えられる.



Fig. 8 Analysis results of electric field distribution. (a) type-A. (b) type-B.

以上から,磁心内部に巻線を有する構造にする場合,本 論文で扱うような薄型トランスの場合は,巻線の位置決め 精度および巻線構造が重要である.

4.3 寄生容量

Fig. 8に巻線近傍断面の電界分布の3次元電磁界シミュ レーション結果を示す.シミュレーションはフルデバイス モデルで行っているが、トランス構造の対称性から結果は 巻線の下半分のみ示している.なお、モデリング上の都合 から、巻線間隔や内側および外側のポリイミド層が実物よ り厚い部分があるが、シミュレーション結果への影響は限 定的であると考えている.

Fig. 8より, type-A とBを比較すると, type-Bの方が 巻線間の電界が大きい.特に 2 分割した 1 次巻線間 (Primary winding-1 と Primary winding-2 の間)におい て大きな電界が生じていることがわかる.また,どちらの 巻線においても電界は巻線間または周囲のポリイミド層に 集中し,メタルコンポジット材料中には生じていない.こ のことは,空心巻線の状態でも 2 つのトランスの寄生容量 に大きな差が生じることに対応している.

上記のように電界分布に違いが現れた理由は,以下のように説明できる. Fig. 9 に示すように、巻線を同心円状の 導体と仮定し、最も内側を 1 ターン目,外側を 16 ターン 目とする. 2 次巻線はフローティングとし無視する.同図(a) より type-A は隣接する巻線とは 1 ターン分の差である. 一 方,同図(b)より type-B では 7 ターンまたは 8 ターンの差 となる. このことを等価回路で表すと, Fig. 10 のように表 すことができる. なお、巻線間の相互インダクタンスは省 略している.

Fig. 10 より,端子 A-B 間に交流電圧が印加されると, 各ターンのインダクタンス $L_1 \sim L_{16}$ により分圧され, type-B の方が隣接する巻線間の電位差が大きくなる.寄生 容量は隣接する巻線間の電位差によって生じるため,電位 差の大きい type-B の寄生容量が大きくなる.



Fig. 9 Circular windings model.





Fig. 10 Equivalent circuit model of windings.

以上から、本論文で用いたようなテープ状導体を巻線と する際は、隣接する巻線との電位差が小さくなるような巻 線構造にする必要がある.



Fig. 11 Circuit diagram of the flyback-type dc-dc converter.

Fabricated transformer



Fig. 12 Photograph of fabricated converter.

Input voltage	48 V
Output voltage	12 V
Maximum output power	60 W
Switching frequency	400 kHz, 1 MHz
Control system	PWM control (Open loop)

Table 2 Specifications of the converter.

5. フライバックコンバータへの応用

5.1 評価回路

Fig. 11 に評価に用いたフライバックコンバータの回路 図, Fig. 12 には試作したコンバータの写真, Table 2 にコ ンバータの主な仕様を示す. 1 次側 MOSFET には Vishay 社製 IRLI640G (耐圧 200 V), 2 次側整流ダイオードには STMicroelectronics 社製 STPS5L60 (耐圧 60 V, 5 A) を 4 個並列に使用している. スイッチング周波数を 400 kHz および 1 MHz として, ファンクションジェネレータ F.G.

(NF回路設計ブロック;WF1974)を用いたオープンルー プPWM 制御を行っており、出力電流を変化させても出力 電圧 Vourが12Vとなるようにオン時比率を調整している.

5.2 効率評価結果

Fig. 13 に効率の評価結果を示す. 400 kHz スイッチング時,約 30 W まではどちらのトランスも同じ傾向を示し,15 W 出力時に最大効率 91%を示した. 全負荷領域で効率特性の傾向を見ると,出力電力 30 W 以下では type-A,30



Fig. 13 Power conversion efficiency versus output power.

W 以上では type-B を用いた方が効率は高くなり, 60 W 出 力時に type-A は約 87%, type-B は約 88%となった.

1 MHz スイッチング時も同様に,出力電力約 30 W まで はどちらのトランスでも同じ傾向を示した.最大効率は type-A が約 82%, type-B が約 85%, 60 W 出力時の効率 はそれぞれ約 80%, 84.5%と 400 kHz スイッチング動作 時よりも 2 つのトランスの差が大きくなった.また,この ときも出力電力 30 W 近傍でコンバータの効率が逆転した.

軽負荷時の効率が type-A を用いたときの方が高いのは, 前述の通り type-B と比較し等価直列抵抗 R。が小さいため と考えられる.一方,重負荷になると結合係数(漏れイン ダクタンス)が影響し,type-Bの方が高くなったと考えら れる. Fig. 14, Fig. 15 に 60 W 出力時のコンバータの動作 波形を示す.サージおよびリンギングが大きいため詳細な 損失分析は難しいが,MOSFET ターンオフ時に大きなサ ージ電圧が生じており,また,その後のリンギングでドレ インーソース間電圧が0 V 付近まで低下している期間があ ることが確認できる.このとき,MOSFET の寄生ダイオ ードに電流が流れ,寄生ダイオードの順方向電圧でクラン プされている状態だと推察される.結合係数が低い type-A の方が大きなサージ電圧が観測されていることから,寄生 ダイオードに流れる電流およびそれによる導通損失が大き く,type-B よりも重負荷時の効率が低下したと考えられる.

ところで400 kHz スイッチング時,出力電力20 W 以下 において,効率特性に複数のピークが現れている.この負 荷領域では,MOSFETのオフ期間中に2次側ダイオード 電流がゼロとなる,電流不連続モード動作となる.2次側 ダイオード電流がゼロになると,トランスのインダクタン スとMOSFETの寄生容量および並列接続された100 pFの コンデンサによって共振モードに入り,ドレイン-ソース 間電圧は正弦波状に変化し始める.スイッチング周期と共 振周期は一定だが,出力電力(オン時比率)の値により共 振モードに入るタイミングは変化するため,ターンオン時 のドレイン-ソース間電圧も変化する.ドレイン-ソース 間電圧が低いときにターンオンするとスイッチング損失は 小さく,逆に高いときにターンオンするとスイッチング損



Fig. 14 Waveforms of converter, where switching frequency is 400 kHz and converter output power is 60 W.



Fig. 15 Waveforms of converter, where switching frequency is 1 MHz and converter output power is 60 W.

失が大きくなるため、効率特性に複数のピークが現れたと 考えられる. Fig. 16には最大効率が得られた 15 W 出力時 の動作波形を示す. 同図より、ドレイン-ソース間電圧が 低下したタイミングでターンオン動作していることが確認 できる. このためスイッチング損失が小さく、最大効率に なっていると推察される. なお、スイッチング周波数が変 わると電流不連続モード動作となる出力電力条件が変化す る. そのため、1 MHz スイッチング時は、Fig.13に示した 出力電力範囲内では効率のピークは現れない.

本論文で評価に用いたフライバックコンバータは,



Fig. 16 Waveforms of converter, where switching frequency is 400 kHz and converter output power is 15 W.

MOSFET に並列接続された 100 pF のコンデンサによりタ ーンオフ時の ZVS (Zero Voltage Switching) も実現されて いる.よって最大効率となる 400 kHz スイッチング, 15 W 出力時は,擬似共振型フライバックコンバータ¹¹¹と同じ動 作である.さらなる高効率化のためには擬似共振型フライ バックコンバータとすることも有効であると考えられる.

6. まとめ

表面酸化カルボニル鉄粉メタルコンポジット磁心トラン スを試作し、フライバックコンバータに適用して効率評価 を行った.以下に得られた結果を要約して示す.

- (1) 表面酸化カルボニル鉄粉メタルコンポジット材料を用い、フライバックコンバータ用トランスを試作した. 巻線に銅張ポリイミドシートを用い、磁心内部に巻線 を配置する構造とすることで、低透磁率材料であって もインダクタンス増大と結合係数を改善できた.
- (2) 試作したトランスの測定結果および電磁界シミュレーション結果から、磁心内における巻線位置ずれがトランスの特性に与える影響が大きいことが明らかとなった.したがって、特に薄型トランスの場合は、磁心内の巻線位置決めの精度が重要になると考えられる.
- (3) 同じ巻数比のトランスであっても、巻線構造によって 寄生容量が大きく異なることが明らかとなった。特に 本論文で用いたテープ状導体を巻線とする際は、隣接 する巻線との電位差が小さくなるように巻線構造に注 意する必要がある。
- (4) フライバックコンバータに適用したところ、スイッチング周波数 400 kHz・出力電力 15 W 時に効率は最大91%、スイッチング周波数 1 MHz のときは、出力電力30 W 以上において効率は 85%となった。

コンバータのさらなる高効率化のためには、コンバータ 仕様に基づくトランス設計の他、巻線配置見直しによる 1 次・2 次巻線間の磁気結合改善と寄生容量低減、メタルコン ポジット材料の比透磁率向上などが必要であると考えられ、 今後検討する予定である.

謝辞 本研究は、科学研究費補助金(課題番号;15H02233), NEDO 低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニ クスプロジェクト/次世代パワーエレクトロニクス応用シ ステム開発の先導研究,ならびにJST研究成果展開事業「京 都地域スーパークラスタープログラム」の補助を受けて実 施されたものであり、ここに謝意を表する.

References

- Antonio León-Masich, Hugo Valderrama-Blavi, Josep María Bosque-Moncusí, and Luís Martínez-Salamero: *IET Power Electronics*, 8, 6, pp.869-878 (2015).
- Hanxing Wang, Alex Man Ho Kwan, Qimeng Jiang, and Kevin J. Chen: *IEEE Transactions on Electron Devices*, 62, 4, pp.1143-1149 (2015).
- 3) K. Sugimura, Y. Miyajima, M. Sonehara, T. Sato, F. Hayashi, N. Zettsu, K. Teshima and M. Mizusaki: *AIP Advances*, 6, 055932-1-8 (2016).

- 4) A. Ueno, K. Sugimura, D. Shibamoto, K. Sato, M. Sonehara, T. Sato, and S. Kanazawa: *IEEJ Zenkoku-taikai 2016*, 2-097, p.118 (2016) (in Japanese).
- 5) D. Shibamoto, A. Ueno, K. Sugimura, R. Hirayama, K. Sato, T. Sato, and M. Sonehara; *The Papers of Joint Technical Meeting on "Magnetics" and "Linear Drives*", MAG-16-041/LD-16-033, pp.17-22 (2016) (in Japanese).
- 6) T. Yamamoto, K. Sugimura, T. Sato, M. Sonehara, YG Bu, T. Mizuno, Y. Yamaguchi, and T. Kano: *The Papers of Joint Technical Meeting on "Magnetics" and "Linear Drives*", MAG-16-050/LD-16-042, pp.63-68 (2016) (in Japanese).
- T. Fujiwara and R. Tahara: *IEEE Translation Journal on Magnetics in Japan*, 8, 11, pp.795-800 (1993).
- 8) J. Togawa: Suicching-dengen no koiru/toransu sekkei (in Japanese), pp.209-212 (CQ shuppansha, Tokyo, 2012).
- 9) K. Ohta: Jikikogaku no Kiso 2 (in Japanese), p. 311 (Kyoritsu Shuppan, Tokyo, 1973).
- 10) K. Sato, K. Sugimura, T. Sato, M. Sonehara: *The Papers of Joint Technical Meeting on "Magnetics*", MAG-16-112, pp.19-24 (2016) (in Japanese).
- 11) Y. Asako, H. Shiroyama, Y. Ishizuka, H. Matsuo; *IEICE Technical Report*, EE2007-64/CPM2007-149, pp.1-6 (2008) (in Japanese).

2016年10月7日受理, 2017年1月10日採録